

# 新时期半导体科学技术发展

## 论坛日程

2019年1月25日（星期五）		
上午 8:30-8:40 开幕式 会议主席：李树深 院士、郝跃 院士		
主题一、微电子集成（主持人：黄如 院士）		
时间	报告人	报告题目
8:40-9:20	皮孝东	面向高性能计算的硅材料现状及其发展
9:20-10:00	黄芊芊	后摩尔时代超低功耗新原理器件
10:00-10:20	茶歇、合影（学术会堂前）	
10:20-11:00	赵毅	关于硅及锗基电子器件研究的一些思考
11:00-11:40	刘琦	阻变存储器发展态势与机遇
11:40-12:20	刘雷波	软件定义芯片-以非对称技术赢得发展主动权
午餐（中国科学院学术会堂自助餐厅）		
主题二、光电子集成（主持人：杨德仁 院士）		
13:20-14:00	李明	光电子芯片技术现状与举措建议
14:00-14:40	冯俊波	后摩尔时代下硅基光电子与微电子的融合与突破
14:40-15:20	刘力源	人工智能视觉系统芯片
15:20-15:40	茶歇	
15:40-16:20	陆丹	战略性高端光电芯片与光子集成平台
16:20-17:00	彭航宇	大功率半导体激光器研究进展与分析
晚餐（中国科学院学术会堂自助餐厅）		

2019年1月26日（星期六）		
主题三、光电子材料与器件（主持人：王立军 院士）		
时间	报告人	报告题目
8:30-9:10	刘雷	氧化物半导体的能带调控与点缺陷单体表征技术探索
9:10-9:50	王新强	氮化物半导体原子层外延调控及其器件
9:50-10:30	徐科	氮化镓单晶材料生长及 GaN on GaN 器件进展
10:30-10:50	茶歇	
10:20-11:00	胡伟达	具有变革性特征的红外光电探测器
11:00-11:40	陆海	宽禁带半导体紫外光电探测器
午餐（中国科学院学术会堂自助餐厅）		
主题四、新兴技术（主持人：刘明 院士）		
13:20-14:00	闵泰	Development History and Technology Future of Emerging STT-MRAM Technology
14:00-14:40	韩根全	铁电负电容逻辑、非易失性存储器和高迁移率沟道器件
14:40-15:20	王欣然	二维电子器件与集成技术
15:20-16:00	讨论	
论坛结束		

注：（1）特邀报告每报告 35 分钟，提问、讨论 5 分钟（可根据实际情况调整）；

（2）讨论环节一般口头发言 3 分钟。